

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-147289

(43)Date of publication of application : 06.06.1990

(51)Int.CI.

B41M 5/26
G11B 7/24

(21)Application number : 63-301176

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 29.11.1988

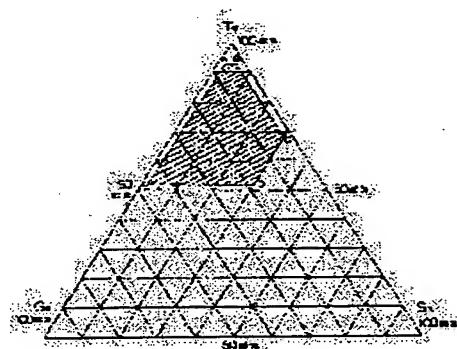
(72)Inventor : KIMURA KUNIO
ONO EIJI

(54) OPTICAL DATA RECORDING MEMBER

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an excellent optical data recording member excellent in the repeating characteristics of recording and erasure, stable to heat and humidity and sufficiently susceptible to blackening and whitening by semiconductor laser power by providing a TeGeSnSb type composition characterized by that the atomic number ration of Te, Ge and Sn is within a specific region and the concn. of Sb is of specific percentage.

CONSTITUTION: An optical data recording member is provided with a composition of $n=5\text{--}40\text{at\%}$ when the atomic number ratio of e, Ge and Sn is within a region surrounded by points A (Te93Ge5Sn2), B(Te93Ge2Sn5), C(Te68Ge2Sn30), D(Te52Ge18Sn30) and E(Te52Ge46Sn2) and the concn. (at% of Sb is represented by $(\text{Te}_x\text{Ge}_y\text{Sn}_z)\text{mSb}_n$). Sb is added to the composition of Te-Ge-Sn to fix excessive Te as a compound. Sb forms a compound along with Te and the m.p. of said compound is $622^\circ\text{ C}(\text{Sb}_2\text{Te}_3)$ at the max. This temp. is lower by 200° C or more than that of Te-Ge or Te-Sn. Therefore, excessive Te can be fixed as a compound without raising the m.p. of the film based on Te.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑨ 日本国特許庁 (JP) ⑩ 特許出願公開
 ⑫ 公開特許公報 (A) 平2-147289

⑪ Int. Cl. 5
 B 41 M 5/26
 G 11 B 7/24

識別記号

庁内整理番号

⑫ 公開 平成2年(1990)6月6日

A 8120-5D
 6715-2H B 41 M 5/26 X
 審査請求 未請求 請求項の数 3 (全8頁)

⑬ 発明の名称 光学情報記録部材

⑭ 特願 昭63-301176

⑮ 出願 昭63(1988)11月29日

⑯ 発明者 木村 邦夫 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
 ⑯ 発明者 大野 銳二 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内
 ⑯ 出願人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
 ⑯ 代理人 弁理士 粟野 重孝 外1名

明細書

1. 発明の名称 記載
 光学情報記録媒体

2. 特許請求の範囲

(1) Te, Ge, Snの原子数比が第1図の
 $A(Te_{0.9}Ge_{0.5}Sn_{2.0})$, $B(Te_{0.9}Ge_{2.0}Sn_{0.5})$, $C(Te_{0.9}Ge_{2.0}Sn_{0.5})$,
 $D(Te_{0.9}Ge_{1.0}Sn_{2.0})$, $E(Te_{0.9}Ge_{4.0}Sn_{0.5})$ 点で囲まれる
 領域内にあって、Sbの濃度nの値が5~
 25 at\% であることを特徴とする請求項1記載の光学情報記録部
 材。

(2) Te, Ge, Snの原子数比が第二図の
 $F(Te_{0.9}Ge_{0.5}Sn_{2.0})$, $G(Te_{0.9}Ge_{2.0}Sn_{0.5})$, $H(Te_{0.9}Ge_{2.0}Sn_{0.5})$,
 $I(Te_{0.9}Ge_{2.0}Sn_{0.5})$ 点で囲まれる領域内にあって、
 Sbの濃度nの値が10~35 at%であるこ
 とを特徴とする請求項1記載の光学情報記録部
 材。

(3) Te, Ge, Snの原子数比が第二図の
 $H(Te_{0.9}Ge_{0.5}Sn_{2.0})$, $J(Te_{0.9}Ge_{1.0}Sn_{2.0})$, $K(Te_{0.9}Ge_{2.0}Sn_{0.5})$,
 $L(Te_{0.9}Ge_{4.0}Sn_{0.5})$, $M(Te_{0.9}Ge_{1.0}Sn_{2.0})$ 点で囲ま

れる領域内にあって、Sbの濃度nの値が5~
 25 at\% であることを特徴とする請求項1記
 载の光学情報記録部材。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は光、熱などを用いて高速にかつ高密度
 に情報を記録、消去、再生可能な光学情報記録部
 材に関するものである。

従来の技術

近年、情報量の増大化や、記録、再生の高速化
 あるいは、高密度化に伴い、レーザ光線を利用し
 た光ディスクが注目されている。光ディスクには
 一度だけ記録可能な追記型と呼ばれる媒体と記録
 した信号を随時消去して何度も記録可能な書換え
 型媒体がある。追記型光ディスクには、記録信号
 を穴空き状態として、再生するものや、凹凸を生
 成させて再生するものがある。書換え可能なもの
 としてはカルコゲン化物を用いる試みがあり、
 Te-Geを初めとして、これにAs, S, Si,
 Se, Sb, Biなどを添加した例が知られてい

る。

これに対し、本発明者等は先に、Te-T₂O₃のような酸化物を含んだ系の相転移による反射率変化を信号として検出する方法を提案した。更に、相転移を利用した書き換え可能な光ディスクとしてTe-T₂O₃に対し、各種の元素(Sn, Ge, Bi, In, Pb, Ti, Seなど)を添加した例が見受けられる。これらの記録部材の特徴は、C/Nが高く、耐湿性に対しても優れるという特徴を有している。

発明が解決しようとする課題

しかし、カルコゲン化物より成る書き換え可能な情報記録部材は、一般的に記録、消去の繰り返しに対する安定性に劣るといった特徴を有する。この理由はTe, Geとその他の添加成分が、数度の繰り返しによって記録膜成分が相分離を生じてしまい初期と繰り返し後では膜の構成成分が異なってしまうことに起因しているものと思われる。書き換え可能な光ディスクでは、未記録状態を非晶質とし、記録状態を結晶とする方法がとられる。

Te, Te, Ge, Snの原子数比が第1図のA, B, C, D, Eの点を結んだ領域内にあるとともに、Sb濃度が5~40at%である組成を備えることを特徴とする。

作用

本発明は、上述した従来組成Te-Ge-SnにSbを添加して過剰のTeを化合物として固定することにある。SbはTeと化合物を形成し、融点が最も高い場合でも622°C(Sb₂Te₃)である。この温度は他のTe-Ge, Te-Snなどと比較しても200°C以上も低い。従って、Sbの添加はTeを母材とする膜の融点を上昇させることなしに過剰なTeを化合物として固定することが可能となる。

実施例

以下に、本発明の実施例を図面を参照して説明する。

本発明は、Te-Ge-Sn-Sbより構成される組成を含む記録媒体である。本発明において、Teは他の元素と結合した状態で記録前後で光学

この場合記録はレーザ光で、一旦記録膜を溶融させ急冷によって非晶質にする訳であるが、現在の半導体レーザにはパワーの限界がありできるだけ記録膜の融点が低い方が記録感度が高いことになる。このために、上述したカルコゲン化物よりなる膜は記録感度を向上させるためにできるだけ融点の低い組成、すなわちTeが多い膜組成となっている。Teが他の添加成分より多いということは、化学量論組成より、それだけずれることになり記録、消去を繰り返した場合に、相分離が生じやすいことになる。したがって、融点を下げるために添加した過剰のTeをいかに化合物として固定化し、安定な組成にするかが繰り返し特性を向上させるためには重要である。

本発明は、このようなカルコゲン化物よりなる従来組成の課題を克服したもので、記録膜組成としてTeGeSnSbを含む光学情報記録媒体を提供することを目的とするものである。

課題を解決するための手段

本発明は、TeGeSnSb系の組成物であつ

的濃度変化を呈する母材である。GeはTeとの濃度比によって非晶質と結晶間の転移速度を支配する。すなわち、Ge濃度が低い領域では(TeとGeのみの場合は、Geが50at%以下)非晶質として安定に存在させるが、濃度が高くなると結晶質状態としての方がより安定となるため、一旦結晶質となったものを非晶質化させることが困難となる。本発明のGe濃度は50at%以下であるので、Geは膜の非晶質性を増大させることに寄与する。Snの役割は、Geと同様ではあるがSnがTeとで非晶質性を増大させる領域は狭く、本発明の範囲ではむしろ、結晶化を促進する。すなわち、GeとSnはTeに対しての作用は似ているが、Teとの濃度比によって、非晶質性が増大したり、結晶質性が増大したりする。GeとSnの濃度が高くなると、膜は結晶質として安定になるため、非晶質から結晶質への転移は容易となるが、逆は困難となる。したがって、こうした材料は追記型材料となる。しかし、こうした材料でもレーザパワーが強く、膜を充分に溶融

させることができれば、替換可能なディスクとして使用することが可能である。現在、我々が実用上入手できる半導体レーザは波長が 830 nm 程度では最大 40 mW 程度であり、Te、Ge、Sn の量論に近い組成 (GeTe; 790°C, SnTe; 725°C) を溶融させることは困難である。Te-Ge-Sn 系で記録、消去が可能な領域は Te が非常に多い領域 (80 at% 以上) にあるが、この領域の組成は転移温度が低く、熱的に不安定であること、Te が過剰であるため、繰り返しによって Te と GeTe あるいは SnTe に記録膜が相分離を生じ易いなどの欠点を有している。

本発明の Sb はこの過剰の Te を Sb と Te の化合物として安定化させる働きを有する。Sb は Te との合金系では Te が 60 at% 以上では、融点が 622°C 以下で Sb を添加しても Te の融点が 451°C なのでそれほど融点を上昇させることはない。そのため、Sb を添加した膜は現行の半導体レーザパワーでも充分に溶融させることができる。

本発明は上記 Te-Ge-Sn の三元系の A-B-C-D-E 点で囲まれた範囲内にあって、かつ Sb 濃度が式 $(Te_xGe_ySn_z)_{1-x-y-z}Sb_n$ で表わした場合、n の値として 5~40 at% の範囲内にある。線 A-B より多い場合、必然的に Ge 濃度は少なくなり非晶質化が困難となる。また、Ge, Sn 濃度が低いため非晶質から結晶質への転移温度も低い。線 B-C より Ge が低い場合も、線 A-B より Te が多い場合と同様に転移温度が低い。また結晶質から非晶質への転移に対する傾向は、Te が多い場合よりも容易である。しかし、実用的な観点からは、不十分である。線 C-D より Sn 濃度が多い場合、Sn の添加は結晶質化を促進するので、非晶質化が困難となる。また、非晶質から結晶質への転移温度も低く、熱的な安定性に乏しい。線 D-E より Te が少ない場合、この領域は、Te と Ge, Sn が化学量論に近い組成で結晶、GeTe, SnTe を形成するので非晶質化が困難となる。また、この領域では過剰な Te がほとんど存在しないので添加する Sb 濃度も少ない。逆に言えば、

できる。熱的に不安定な過剰な Te を Sn_xTe_{1-x} として化合物を形成しているため、熱的に安定で、かつ記録、消去の繰り返しによっても相分離を生ずることなく長期に亘って安定な膜となる。

Sb の添加量は、Ge, Sn と結合した残りの過剰 Te を固定化するので必要な Sb 濃度は Te / (Ge + Sn) の量に支配される。すなわち、Te 濃度が高い領域では Sb 濃度は高い。

第 1 図に本発明の Te-Ge-Sn-Sb より構成される記録組成の適正範囲を示した。図は Te-Ge-Sn より構成されているが Sb 濃度は第 1 図に示された Te-Ge-Sn 組成に対し、5~40 at% である (Sb 濃度は $(Te_xGe_ySn_z)_{1-x-y-z}Sb_n$ で示した場合の n に相当)。

第 1 図において各点は以下の組成である。

A 点	$Te_{0.2}Ge_{0.8}Sn_{0.2}$	(at%)
B 点	$Te_{0.3}Ge_{0.7}Sn_{0.5}$	
C 点	$Te_{0.6}Ge_{0.2}Sn_{0.2}$	
D 点	$Te_{0.2}Ge_{0.8}Sn_{0.8}$	
E 点	$Te_{0.2}Ge_{0.4}Sn_{0.2}$	

Sb の添加量も少ない。したがって、この領域は非晶質化が困難となる。

線 E-A より Sn が少ない領域では、非晶質として安定であるので結晶質化が困難である。ただしこの傾向は E-A 線上の Te と Ge の比によって支配され、Te が多いほど結晶化が容易で、Te 濃度が 70 at% 付近が最も結晶化が困難となり、Te が 50 at% 付近で、再び結晶化が容易となる。この理由は Te と Ge が非晶質として、より安定な化合物 GeTe₂ を形成するためで、Te 濃度が 70 at% 付近では、全体的に結晶質化が困難である。

以上述べた理由により、本発明は、第 1 図において点 A-B-C-D-E で囲まれた範囲内に限定される。すなわち、この領域内の Te-Ge-Sn に Sb を 5~40 at% 添加した場合、実用上、結晶質と非晶質の可逆性を利用して、情報の記録、消去が可能となる。

次に、第 2 図の実施例について述べる。

第 2 図は、第 1 図と同様に Te-Ge-Sn と

Sbよりなる本発明の組成範囲を示したもので第1図より、より実用的な組成範囲を示してある。第2図において各点の組成を以下に示す。

F点	$T_{e_{0.2}}G_{e_{0.5}}S_{n_{0.3}}$ (at%)
C点	$T_{e_{0.2}}G_{e_{0.5}}S_{n_{0.5}}$
H点	$T_{e_{0.2}}G_{e_{0.5}}S_{n_{0.2}}$
I点	$T_{e_{0.2}}G_{e_{0.3}}S_{n_{0.3}}$
J点	$T_{e_{0.2}}G_{e_{0.2}}S_{n_{0.3}}$

このF-G-H-I点で囲まれた領域におけるSb濃度は10~35at%である (Sb濃度は(T_e, G_e, S_n) $\cdot S_b$ で示した場合のnに相当)。

H点	$T_{e_{0.2}}G_{e_{0.5}}S_{n_{0.2}}$
J点	$T_{e_{0.4}}G_{e_{0.3}}S_{n_{0.3}}$
K点	$T_{e_{0.2}}G_{e_{0.2}}S_{n_{0.3}}$
L点	$T_{e_{0.2}}G_{e_{0.1}}S_{n_{0.3}}$
M点	$T_{e_{0.2}}G_{e_{0.0}}S_{n_{0.3}}$

このH-J-K-L-M点で囲まれた領域に於けるSb濃度は5~25at%である。

まず第2図の上段点F G H Iで囲まれた領域の

領域に比べ期待できない。しかし、Sbなしの $T_e - G_e - S_n$ 系に比べると非晶質化は容易である。JKLM点で囲まれた領域の特徴は、転移温度が高く、熱的に安定であること、 $G_e T_e$ 、 $S_n T_e$ の黄緑に近い組成なので結晶化が容易で非晶質化が困難なことであるが、半導体レーザを高出力なものを用いれば、非晶質化は容易となる。点IJKで囲まれた部分は安定な非晶質状態の $G_e T_{e_2}$ が存在する領域で結晶化が困難である。以上述べた理由により、本発明の $T_e - G_e - S_n - S_b$ の最適組成は限定される。

次に、本発明による光学的情報記録部材の製法について述べる。第3図は、本発明の記録層を用いて構成した光ディスクの断面の模式図である。図において1、5は基板を表わしており、材質はポリカーボネート、アクリル樹脂、ガラス、ポリエチルなどの透明な基材を用いることが可能である。2、4は保護層で、種々の酸化物、硫化物、炭化物を用いることができる。この保護層2、4は記録層3の記録、消去の繰り返しによる基材の

特徴について述べる。この領域の非晶質から結晶質への転移温度は120~205°C以内であり、後述する点HJKLM点で囲まれた領域に比べると低い。Sbの添加は $T_e - G_e - S_n$ だけよりもなる系に比べ、結晶への転移温度を20~50°C高める働きを有する。しかもSbの添加によって膜の融点は下がるため、非晶質化に対しては都合がよい。この理由は、Sbは単独でも630°Cで T_e との化合物 Sb_2Te_3 でも622°Cと比較的低いことに起因する。一方、 G_e 、 S_n の場合は T_e 濃度に対し、50%以下の場合、各々最大で725°C、790°Cとなる。それ故、Sbの添加は熱的安定性を示す転移温度を上昇させる効果と膜の融点を下げ、非晶質化を容易にするといった利点を有する。

次に、HJKLM点で囲まれた領域について述べる。この領域の結晶転移温度は140°C~230°C程度である。

前述したように、この領域は過剰の T_e が少ない領域でSbの添加効果はFGHI点で囲まれた

熱劣化を防ぐものであり、さらに、記録層3を温度より保護するものである。したがって、保護層の材質、膜あつは上述した観点より決定される。記録層3は蒸着、スパッタリング等によって形成される。蒸着で行なう場合は各組成を単独に蒸着可能な4元蒸着機を用いるのが、均一な膜を形成できるので望ましい。

本発明の記録層3の膜厚は、保護層2、4の光学的特性とのマッチング、すなわち、記録部と未記録部との反射率の差が大きく取れる値とする。

以下、具体的な例で本発明を詳述する。

実施例1

4元蒸着が可能な電子ビーム蒸着機を用いて T_e 、 G_e 、 S_n 、 S_b をそれぞれのソースから蒸着した。用いた基材はφ8mmのガラスで、蒸着は真空度が 1×10^{-5} Torr、基材の回転速度が150 rpmで行い、膜厚は100nmとした。各ソースからの蒸着速度は記録層中の T_e 、 G_e 、 S_n 、 S_b の原子数の割合を調整するため変化させた。第1表の組成の割合は、この蒸着の

速度より換算した値であるが、代表的な組成を X 線マイクロアナライザー (XMA) で行なったところ、仕込値とほぼ同様の定量結果が得られた。

(以下余白)

第一表

No	組成	温度	黒化	白化
A	(Te ₉₂ Ge ₆ Sn ₂) ₇₈ Sb ₃₀	115	◎	△
B	(Te ₉₃ Ge ₂ Sn ₅) ₇₈ Sb ₃₀	110	◎	×~△
C	(Te ₈₈ Ge ₂ Sn ₃) ₈₂ Sb ₈	125	◎	△
D	(Te ₈₂ Ge ₁₈ Sn ₃) ₉₅ Sb ₅	205	△	△
E	(Te ₈₂ Ge ₄₈ Sn ₂) ₉₅ Sb ₅	235	◎	×~△
F	(Te ₉₂ Ge ₅ Sn ₃) ₇₈ Sb ₃₀	130	◎	△
G	(Te ₉₂ Ge ₃ Sn ₅) ₇₈ Sb ₃₀	125	◎	△
H	(Te ₈₈ Ge ₃ Sn ₂) ₉₅ Sb ₅	140	◎	△
I	(Te ₇₄ Ge ₂₃ Sn ₃) ₉₅ Sb ₅	205	△	◎
J	(Te ₇₆ Ge ₁₈ Sn ₂) ₉₅ Sb ₅	180	△	◎
K	(Te ₈₈ Ge ₂₃ Sn ₃) ₉₅ Sb ₅	195	△	◎
L	(Te ₈₂ Ge ₄₈ Sn ₂) ₉₂ Sb ₈	230	○	○
M	(Te ₈₂ Ge ₁₈ Sn ₂) ₉₂ Sb ₈	210	○	△

第一表(つづき)

1	(Te ₈₈ Ge ₁₈ Sn ₂) ₇₂ Sb ₂₈	135	○	○
2	(Te ₈₈ Ge ₂₃ Sn ₃) ₇₂ Sb ₂₈	120	◎	○
3	(Te ₈₈ Ge ₁₅ Sn ₁₅) ₇₅ Sb ₂₅	155	○	△
4	(Te ₈₈ Ge ₁₈ Sn ₁₀) ₇₅ Sb ₂₅	145	○~◎	○
5	(Te ₈₈ Ge ₁₅ Sn ₁₅) ₇₅ Sb ₂₅	140	◎	○
6	(Te ₇₆ Ge ₁₅ Sn ₁₀) ₉₈ Sb ₂	185	○	◎
7	(Te ₇₆ Ge ₁₈ Sn ₁₀) ₉₈ Sb ₂	170	○	△
8	(Te ₈₅ Ge ₂₃ Sn ₁₀) ₉₈ Sb ₂	190	△	△
9	(Te ₈₅ Ge ₁₇ Sn ₁₀) ₉₈ Sb ₂	180	○	△
10	(Te ₈₈ Ge ₁₈ Sn ₂₅) ₉₈ Sb ₂	170	◎	△
11	(Te ₈₈ Ge ₂₃ Sn ₇) ₉₂ Sb ₈	205	○	×~△
12	(Te ₈₈ Ge ₂₃ Sn ₅) ₉₂ Sb ₈	200	○	△
13	(Te ₈₈ Ge ₁₅ Sn ₂₅) ₉₂ Sb ₈	180	○	△
14	(Te ₈₈ Ge ₂₃ Sn ₇) ₉₅ Sb ₅	215	◎	×~△
15	(Te ₈₈ Ge ₂₃ Sn ₅) ₉₅ Sb ₅	210	○	△
16	(Te ₈₈ Ge ₂₃ Sn ₂) ₉₅ Sb ₅	210	○	△

したがって、表中の仕込組成は膜中でも同じと思われる。

上記製法によって作成された試験片の評価方法を以下に記す。

「転移温度」

転移温度とは蒸着直後の非晶質状態の膜が熱によって結晶状態になる、その開始温度を意味する。測定は、膜の透過率の測定が可能な装置を用い、ヒータにより試験片の温度を、昇温速度60°C/minで上界させた場合の透過率が減少を開始する温度とした。

転移温度が高いことは、膜が熱的に安定であることを意味する。

「黒化、白化特性」

黒化特性とは、非晶質から結晶質への相変化に対しての転移のし易さを示したもので、逆に白化特性は結晶質から非晶質の転移のし易さを示したものである。

測定は、φ8mmのガラス片上の記録膜に、レンズを用いて、レーザ光を集光させサンプル片を

移動可能な装置を用いて行なった。レーザ光のスポットは $4.5 \times 0.4 \mu\text{m}$ 、パルス幅 4.00 n s 、パワー密度 $10.6 \text{ mW}/\mu\text{m}^2$ 、波長は 900 nm とした。黒化特性は、試験片を比較的緩やかに移動させた場合の相変化のし易さ（非晶質から結晶質）を観察し、容易で、かつ未記録部分と記録部分のコントラスト比が充分大きいものを◎とした。×は緩やかに移動させても黒化しないものを示す。○、△は◎と×の中間に位置する。この定性的な表現において、実用可能な黒化特性は○以上である。

次に、白化特性について述べる。白化特性を観察する場合は、まず記録膜を一旦黒化し、その上で試験片を速やかに移動させ急冷状態を作り、白化（結晶質から非晶質への転移）させる。白化状態が◎にのものは移動速度が比較的緩やかでも、白化し、しかも非晶質部分と結晶質部分のコントラスト比が大きいものを示し、×は全く白化しないものを示している。○と△は、◎と×の中間に位置する。

上述した表現によれば、黒化、白化特性とも非常に優れている場合は、◎、○となるが、実際問題としては、同じ移動速度で、どちらも◎となることはありえず、望ましい材料としては、◎、○あるいは◎、△と多少黒化特性が優るものが良い。

第1表に、本発明の範囲で作成した膜の転移温度と、黒化、白化特性の結果を示す。第4図には、第1表に対応する Te - Ge - Sn 系の三角図を示す。

第1表より明らかのように、本発明の範囲内にある Te - Ge - Sn - Sb 系は黒化特性が×か、白化特性が×であるものではなく、この範囲内にある記録部材は加熱条件によって非晶質状態と結晶質状態を取ることができ、光学的にも情報の書き込み、消去が可能である。

実施例 2

実施例 1 と同様な作成法、評価法で Te - Ge - Sn 系に Sb を添加した場合の濃度依存性を検討した結果を第2表に示す。

（余白）

第2表

No	組成	Sb 濃度 (n)	転移温度 (°C)	黒化特性	白化特性
17	$(\text{Te}_{0.8}\text{Ge}_{0.1}\text{Sn}_{0.1})_n\text{Sb}_n$	8	110	△	○
18		10	125	○	△
19		15	130	○	○
20		20	145	○～◎	○
4		25	155	○～◎	○
21		30	160	◎	○
22		35	170	○	◎
23		37	180	△	◎
24	$(\text{Te}_{0.8}\text{Ge}_{0.2}\text{Sn}_{0.1})_n\text{Sb}_n$	1	195	◎	×
25		3	200	◎	×～△
26		5	205	◎	○
12		8	210	○	△
27		10	215	○	△
28		20	225	○	△
29		25	235	△	△
30		27	210	×～△	△

第2図に置いて F G H I で囲まれた領域からは第4図の 4 で示される $(\text{Te}_{0.8}\text{Ge}_{0.1}\text{Sn}_{0.1})$ 点を選択し H J K L M で囲まれた領域からは、第4図の 1 2 $(\text{Te}_{0.8}\text{Ge}_{0.2}\text{Sn}_{0.1})$ を選択した。第2表において Sb 濃度とは $(\text{Te}_{0.8}\text{Ge}_{0.1}\text{Sn}_{0.1})_n\text{Sb}_n$ で表わした場合、n の値を表わす。

第2表の結果より明らかのように、第2図の F G H I で囲まれた領域にある場合の Sb 濃度は、1.0 at% から 3.5 at% にある場合、黒化、白化特性が○、△より○、◎と良好である。

第2図の H J K L M で囲まれた領域にある場合の Sb 濃度は 5 ～ 2.5 at% である。5 at% 以下 (No. 24, No. 25) は白化せず、替換可能な記録部材とはならない。No. 24 および 25 は本発明の範囲外で参考例である。Sb 濃度が 2.5 at% 以上の場合、No. 30 は黒化特性が×～△で、一応黒化が可能ではあるが、実用性の観点からは使用は困難である。したがって、H J K L M で囲まれた領域にある場合の Sb 濃度は 5 ～ 2.5 at% である。

実施例 3

基材として、 $1.2 t \times \phi 200$ mmのポリカーボネート樹脂基材を用い、記録膜として実施例2のNo.21 ($T_{0.8}Ge_{1.0}Sn_{1.0}Sb_{0.1}$)の薄膜とNo.26の薄膜を形成して2種類の光ディスクを試作し評価した。

各記録薄膜の形成方法は、実施例1と同様であるが、記録膜を形成する前に、耐熱層としてZnSを90 nm蒸着し、記録膜を形成後も180 nm蒸着した。これら2種類のディスクを用いて、記録、消去パワーをそれぞれ8 mW、15 mWとし、記録レーザビームは半価幅で約1 μ m、消去レーザビーム長は、半価幅で約 1×1.5 μ mの長方形円状とし白化状態で記録、黒化状態で消去を行なった。なお、記録周波数は2 MHz、ディスクの周速は、5 m/sである。

No.21のC/Nは55 dB、消去率は5.3 dBであり、No.26のC/Nは50 dBで、消去率は4.9 dBであった。

実施例 4

実施例3の基材を用いて、実施例1のNo.5の光ディスクを作成した。耐熱層はZnSを用いた。膜厚は第一層目のZnSを86 nm、記録層を30 nm、第二層目のZnSを195 nmとした。このディスクのC/Nは56 dBで消去率は5.5 dBであり、実施例5における繰り返し試験を行なったところ、10万回後のC/Nの低下は-2 dBであった。

発明の効果

本発明によるTe-Ge-Sn-Sb記録膜は、Sbの添加によりTe-Ge-Sn系より結晶化、非晶質化領域が拡大され、かつ記録、消去の繰り返し特性が優れ、消去率の経時変動も少ないという特徴を有する。しかも、熱や湿度に対しても安定であるにもかかわらず、膜の融点が低いので現行の半導体レーザパワーで充分に黒化(消去状態)白化(記録状態)が可能で、実用上極めて優れた光学情報記録部材を提供することができるものである。

4. 図面の簡単な説明

実施例3におけるNo.21の光ディスクを用いて、寿命試験を80°C、60%RHの条件下で行なった。

試験方法は、予め情報を記録しておき、上記条件で保持後のC/Nの劣化、消去率の経時変化をみた。一ヶ月経過後のC/Nの低下は-0.5 dBで、消去率の低下は1 dBであった。

実施例 5

実施例3において、No.21の光ディスクを、耐熱層として、GeO₂とSiCを用い、それぞれレーザ入射光側の膜厚を80 nmとして蒸着後、記録膜を形成した。その上に、さらに同様の耐熱層を190 nm蒸着して試料とした。これらのディスクのC/NはGeO₂を用いた場合で54 dB、SiCで52 dBで、消去率は各々、4.8 dB、5.0 dBであった。さらに、実施例4の寿命試験を行なったところ、一ヶ月経過後で、GeO₂を用いた場合で、C/Nの低下は-3 dB、SiCは-0.8 dBであった。

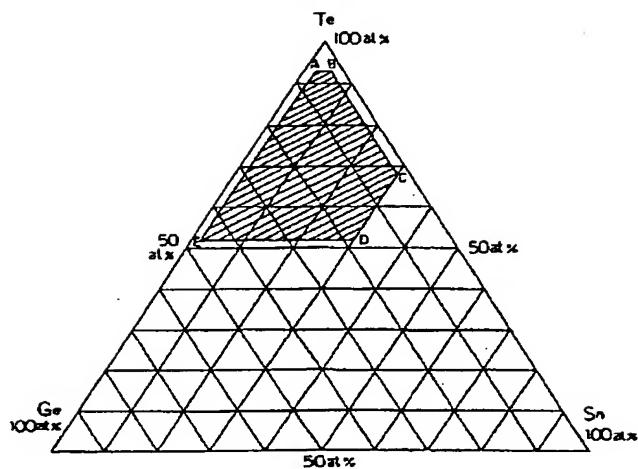
実施例 6

第1図は本発明による光学情報記録部材の組成の範囲を示す組成図、第2図は第1図の組成を、さらに限定した範囲を示す組成図、第3図は本発明の光学情報記録部材の一実施例における構成を示した断面図、第4図は本発明の実施例1、2における各試料の組成を示した組成図である。

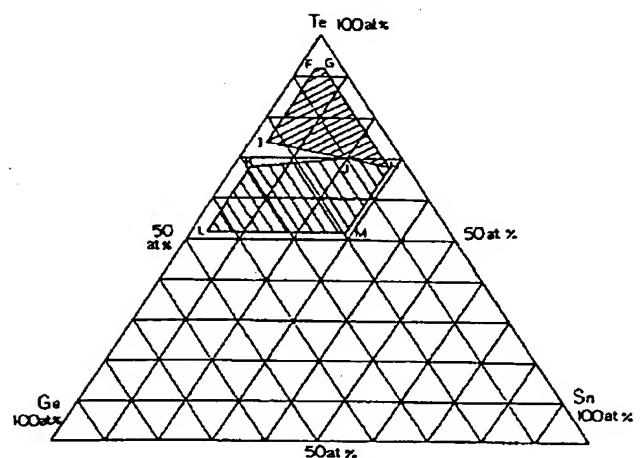
1、5…基板、2、4…保護層、3…記録膜。

代理人の氏名 弁理士 萩野重孝 ほか1名

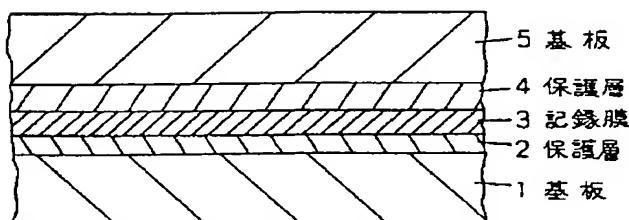
第 1 図



第 2 図



第 3 図



第 4 図

